

# 設備作業標準( SE-002 反應式離子蝕刻系統)

---

## 一、目的：

定義電漿反應式離子蝕刻系統操作規範，以確保操作品質。

## 二、範圍：

適用於電漿反應式離子蝕刻系統。

## 三、權責：

1. 組織權責：工程師負責制定及修改規範。
2. 執行人員資格：經過反應式離子蝕刻系統考核通過之人員。

## 四、名詞定義：

無。

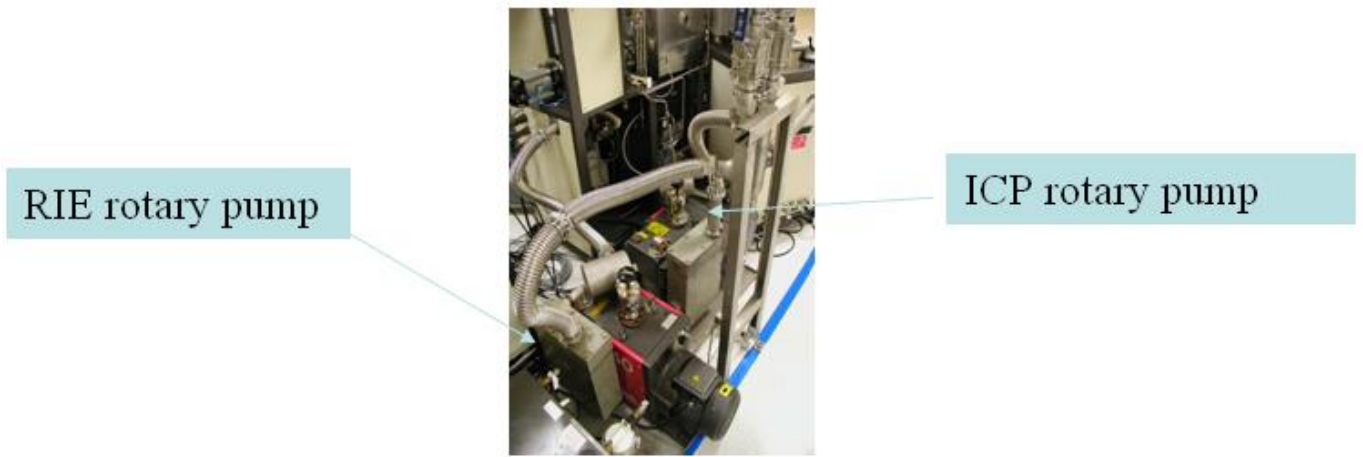
## 五、相關文件：

無。

## 六、標準作業程序：

1. 刷卡開機。
  2. 請確認機台狀況指示牌為運轉中。
  3. 檢查 pump 的狀態(Rotary 是否均有運轉聲，turbo pump 是否均有在 800 轉以上)。(見圖一及圖二)
  4. 檢查冷卻水壓(4 kgw/cm<sup>2</sup>)及冰水機(低於 16 度)是否正常。(見圖三)
  5. 確認全自動操作畫面螢幕顯示。(見圖四)
  6. 打開 Load Lock 上蓋，放入 6 吋晶圓，平邊朝上，蓋回上蓋。(見圖五)
  7. 點選右下角 **RIE 製程參數**或 **ICP 製程參數**，進入後點選製程參數表，可進入製程參數目錄，確認所需製程參數編號，回製程參數表輸入編號，讀取參數，回全自動畫面，執行 **RIE 製程全自動啟動**或 **ICP 製程全自動啟動**。(見圖六、七)
  8. 製程完畢晶片自動傳出至 Load Lock 腔體破真空完成取出。
  9. 製程參數: 氮化矽蝕刻，光阻蝕刻。
-

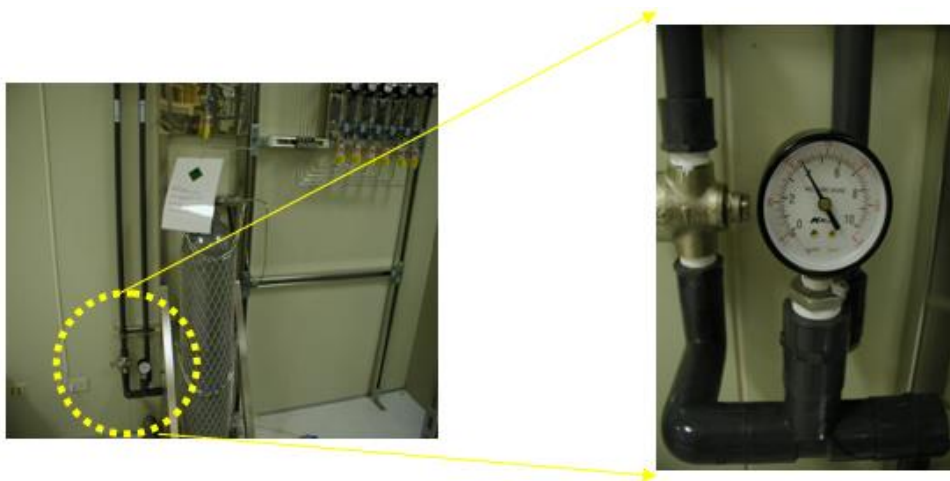
# 設備作業標準( SE-002 反應式離子蝕刻系統)



圖一

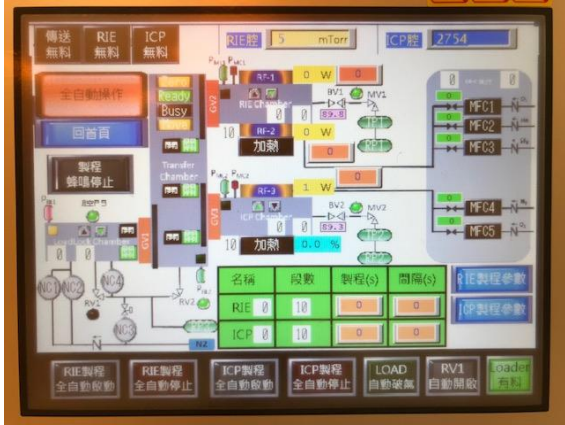


圖二



圖三

# 設備作業標準( SE-002 反應式離子蝕刻系統)



圖四



圖五



圖六



圖七